

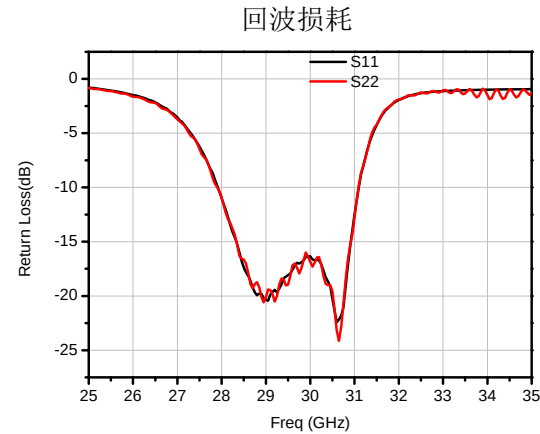
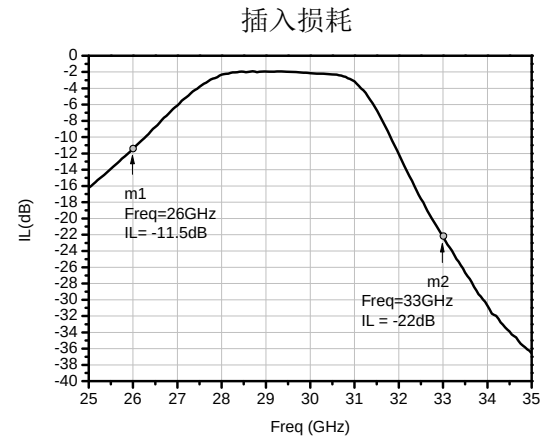
关键指标

通带频率：28~30.5GHz
插入损耗：2dB
阻带衰减：11.5dB@26GHz ,22dB@33GHz
回波损耗：15dB/15dB
芯片尺寸：1.5mm×1mm

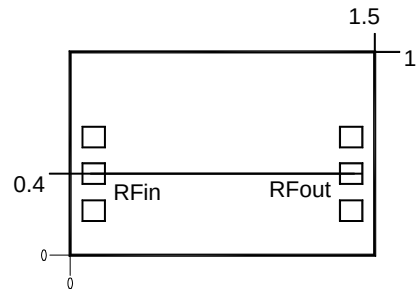
电性能（TA=25℃）

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	28~30.5		
输入回波损耗(dB)	-	15	-
输出回波损耗(dB)	-	15	-
插入损耗(dB)	-	2	-
阻带衰减 @26GHz(dB)	-	11.5	-
阻带衰减 @33GHz(dB)	-	22	-

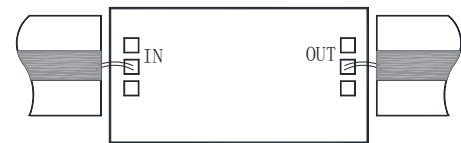
典型测试曲线



外形和端口尺寸（mm）



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
- 2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
- 5. 芯片微波端无隔直电容；
- 6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。